		обо	loз. озна- ение		-	Наи	менование	Кол.	Примечание
Перв. примен.									
в. пр						К	онденсаторы		
Пер		C1		10мкФ X5R 10% 10В 0805, GRM21BR61 Электролитический			1		
		C2		100 мкФ ЕСАР Электролитический			1		
Ш		C3		10пФ NPO 50В 5% 0805, Керамический			1		
Справочный №		(C 4	1500мкФ, ECAP 10B, 105°C, 20%			1		
		C5		2.2пФ NPO 50B, 5%, 0805 Керамический			1		
		(C6	470 мкФ ECAP AXIAL (К50-29), 63В Электролитический			1		
		(C7	2.2мкФ X7R 25B 0805 Керамический			1		
		C8		0.1мкФ X7R 10% 1kB 2220 Керамический			1		
		C9		5600пФ Х7	5600пФ X7R 50В 10% 0805 Керамический			1	
		C10		45 мкФ, 250 B, 5% Керамический			1		
		C	C11	0.1 мкФ Х7	7R 10% 2	50B k	Серамический	1	
		C12		0.33мкФ X7R 10% 25В 0805 Керамический			1		
		C13		8200пФ X7R 50В 10% 0805 Керамический			1		
		C14		470 мкФ, ECAP AXIAL, 100В Электролитический			1		
		C	C15	150пФ NPC	O 50B 5%	6 0805	Керамический	1	
цата									
						Диодный мост			
Подпись и		D1, D2		КВРС5010, Диодный мост 50А 1000В			2		
По,									
6л.				Микросхемы					
Инв. № дубл.		DA1		LD111 "STMICROELECTRONICS"			1		
Инв.		DA2		TNY265 "All POWERINT"			1		
Ñ		D	D1	EPS8266 "I	Espressif	Systei	ms"	1	
Взам. инв. №		DD2		XY-LPWM "Shenzhen Alisi Electronic Technology"			1		
Взам									
a								<u> </u>	
и дат									
Подпись и дата									
Под		Изм. Лист		No wayang			l.001 Э3		
		изм. Разра		f		дата	Модуль преобразователя	J	Іит. Лист Листов
і подл		Пров Нач		Мадвейко			напряжения		У 1 3
Инв. № подл.		Нач. отд. Н.контр.					Перечень элементов		БГУИР гр.810201
I		Утв.					1		Формат АЛ

	Поз. Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Микросхемы		
	DD3	TCA785HKLA1 "SIEMESNS"	1	
		Реле		
	K1, K2	SRD-05VDC-SL-C "SONGLE"	2	
		Резисторы		
	R1	0.125Вт 0805 10 кОм, 1%	1	
	R2	0.125Вт 0805 3.6 кОм, 1%	1	
	R3	0.125Вт 0805 2 кОм, 5%	1	
	R4	0.125Вт 0805 1 кОм, 1%	1	
	R5	0.062Вт 0402 200 кОм, 1%	1	
	R6	0.125Вт 0805 100 кОм, 5%	1	
	R7	0.125Вт 0805 15 кОм, 5%	1	
	R8	0.125Вт 0805 10 кОм, 5%	1	
	R9	0.125Вт 0805 10 Ом, 1%	1	
	R10	0.250Вт 0805 10 кОм, 5%	1	
а	R11	0.250Вт 0805 2 кОм, 5%	1	
Подп. и дата	R12, R13	0.25Вт 1206 100 кОм, 5%	2	
одп.	R14	0.125Вт 0805 1.5 кОм, 5%	1	
	R15	0.125Вт 0805 56 кОм, 1%	1	
/бл	R16	0.125Вт 0805 91 кОм, 1%	1	
Инв. № дубл	R17	0.125Вт 0805 240 Ом, 1%	1	
Инв	R18	0.125Вт 0805 110 кОм, 1%	1	
No	R19	0.125Вт 0805 56 кОм, 5%	1	
Взам. инв. №	R20-R27	0.125Вт 0805 82 кОм, 1%	6	
Baan	R28	3006P-1-501LF, 500 Ом, Резистор подстроечный	1	
_				
Подп. и дата				
одп. 1				
П				
Щ				
Инв. № подл			011 001	Лист
Инв	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата I УИР.363	ГУИР.565211.001 Э1	

Поз. Обозна- чение	Наименова	ние	Кол.	Примечание
	Трансформато	ры		
T1, T2	TI-EE16-1534 "FERYSTER"		2	
Т3	ALT3232M-151-T001 "TDK"		1	
T4	ТПА-20-5в		1	
	Оптроны			
U1, U2	4N25, Оптопара с транзисторным в	ыходом	2	
	Диоды			
VD1-VD2	1N5819, 1A/25A, 40B		2	Диод Шоттки
VD3-VD10	FR207, 2A, 1000B		8	
VD11-VD13	SB3100, 100B 3A		3	Диод Шоттки
	Транзисторн	Ы		
VT1	2N7002, 60B, 0.2A	1		
VT2	КТ819А, 40В, 10А, 60Вт, 3МГц	1		
VT3	GT60N321, IGBT 1000V 60A	1		
VT4 – VT5	2SC2785, 40B, 0,1 A		2	
	_			
			+	
			+	
			+	
		FVIAD 56501	1 00	1 Э1
Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата	ГУИР.565211.001 Э1		1 31

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Инв. № подл